■ 講座 高周波によるプラズマ加熱技術入門

5. 百ギガヘルツ帯ミリ波の利用 -電子サイクロトロン共鳴加熱装置技術-

下 妻 隆 核融合科学研究所 (原稿受付:2006年5月15日)

百ギガヘルツ帯ミリ波の核融合プラズマ加熱への適用として,電子サイクロトロン共鳴加熱法について,そ のシステムに関する関連技術を図や写真を使って解説した.システムの構成に始まり,ジャイロトロン,高電圧 電源,伝送系コンポーネントなどについて説明している.特にシステムの主要部を占めるジャイロトロン管につ いては,発振原理とその動作特性について実際に運転する立場にたって記述した.その際には基本となる数式や 図表を用いて主要パラメータどうしの依存関係を示し,直感的に相互関係が理解できるように配慮した.また大 電力ミリ波の伝送系についても,それを構成する主要コンポーネントについてなるべく平易に説明した.

Keywords:

ECH, gyrotron, corrugated waveguide, MOU (Matching Optics Unit), millimeter wave, miterbend, power monitor, dummy load, ITER, polarizer, remote steering antenna

5.1 はじめに

電子サイクロトロン共鳴加熱・電流駆動(Electron Cyclotron resonance Heating & Current Drive: ECH & ECCD) の核融合プラズマでの役割は、プラズマ生成と電子加熱と それによるプラズマの温度・電流分布制御に集約される. ITER では初期プラズマの生成や加熱,電流駆動や新古典 テアリングモードの抑制に必要な装置として170 GHzで24 ユニット(1ユニットは発振出力として1MWである),20 MWの入射パワーが、またプラズマスタートアップ用とし て120 GHz の 3 ユニットが当初から計画されている[1]. また,現在すでに6-9本のジャイロトロン管を同時運転 し数 MW のパワーを入射してプラズマ実験を行っている 研究所が多数存在している[2]. 例えば, 核融合科学研究所 (NIFS)のLHD装置における9台のジャイロトロンシステ ムや、スイスローザンヌプラズマ研究センター (CRPP)の TCV 装置における9台のジャイロトロンシステムが挙げ られる. 建設中のものとしてはドイツマックスプランクプ ラズマ物理研究所(IPP)のW7-X装置での10台ジャイロト ロンシステムや米国DIII-D装置における6台のジャイロト ロンシステムがある.

ジャイロトロン管はその性能が日々更新されているもの であるが、現時点で高い総合性能を上げているジャイロト ロン管の性能をまとめておく.まず、ITER 用として 170 GHz のものが開発されており、出力 0.9 MW でパルス幅 9 秒、0.6 MW で1000秒(日本: JAEA)、0.9 MW でパルス幅 21秒, 0.5 MW で80秒 (ロシア:GYCOM) の出力が得られ ている.また,W7-X用として140 GHzのジャイロトロン管 が開発されており,0.92 MW で1800秒 (EU: FZK-MPP), 0.9 MW で1800秒(米国:CPI)のものが報告されている.単 管として1メガワット出力で数十分の連続運転が可能な ジャイロトロン管の実現はもう間近である.さらに,ITER 用の次期ジャイロトロンとして単管出力2 MWの同軸キャ ビティ型ジャイロトロンの開発が着手されている (FZK-CRPP).

本章では、ECH のシステムについて、技術的見地よりそ の構成、コンポーネントを図や写真を使って解説する.特 に主要部を占めるジャイロトロン管については、発振原理 とその動作特性についてを実際に運転する立場になって記 述する.その際には基本となる数式や図表を用いて、主要 パラメータどうしの依存関係を示し、直感的に相互関係が 理解できるように配慮した.また、大電力ミリ波の伝送系 についても、それを構成する主要コンポーネントについて なるべく平易に解説した.これらを通読してECHのシステ ム構成の骨子の部分を理解していただき、これらを利用、 運用していく上で少しでも参考になれば幸いである.

5.2 ECH システムの構成

Fig.1は、一般的な ECH のシステム構成を模式的に示したものである. 百ギガヘルツ帯の大電力ミリ波はジャイロトロンと呼ばれる電子管で発生する. そのミリ波は準光学

5. Fusion Plasma Application of Electromagnetic Waves with Hundred Giga Hertz Range of Frequency – Technologies of Electron Cyclotron Resonance Heating Devices–

SHIMOZUMA Takashi

author's e-mail: shimozuma.takashi@LHD.nifs.ac.jp



Fig.1 ECH システム構成の概要を示す.

的結合器 (Matching Optics Unit: MOU) と呼ばれる複数枚 のミラーによって, 伝送系のコルゲート導波管に導かれ る. 長距離に渡って伝送されたミリ波は, 真空窓を介して プラズマ容器内に導入され、集光鏡、可動鏡から構成され る準光学アンテナによって、プラズマ中のある設定された 位置に集光され加熱することになる. ECHシステムにおい ては各構成部品間相互に協調がとられ、高度に集約された システムとして成り立っていることに注意しなければなら ない. 例えば、ジャイロトロンは真空管であり、これを動 作させるためには60-90 kV の高電圧,数十アンペアの電 流を供給する必要がある. さらに数種類の高電圧電源, ヒータ電源,イオンポンプ,超伝導マグネット,油絶縁タ ンクなどが必要となる.またジャイロトロン各部の冷却の ための冷却水設備、とりわけ定常動作ともなると冷却水と して1000 ℓ/minにも及ぶものが必要となることがある. 伝 送系では、長距離伝送のためのコルゲート導波管をはじ め、パワーを測定するためのダミーロードやパワーモニ ター、偏波器、導波管スイッチ等のミリ波帯でハイパワー 使用可能な各種コンポーネントが必要となる.一般に市販 されているものは少なくそれぞれに開発要素がある.プラ ズマ装置への入射窓は、ジャイロトロンの出力窓と同様 に、ミリ波帯で損失の少ない丈夫な材質が要求されてお り,近年ではプラズマ CVD で作製される多結晶人工ダイ アモンドが使用されるようになってきている. アンテナ は, 集光鏡または平面鏡のミラー列から構成され, 真空容 器内に導かれたミリ波は、設計されたビームウエストサイ ズで、プラズマの加熱位置に集光される.通常は最終ミ ラーを可動鏡として、 プラズマ中での加熱位置を変化でき るようになっている.ジャイロトロンの異常のみならず, 伝送路中でのアーキングや真空度異常、温度異常などが発 生した場合には、即座に運転を停止するようなインター ロック系も完備しなければならない.

5.3 ジャイロトロンの構造,発振原理とその特性 5.3.1 ジャイロトロンの構造

ECH システムのなかで最も重要で,現在も高パワー 化,長パルス化の開発が進められているのが,ジャイロト ロン発振管である.Fig.2に最近使用されている出力1 MW 級,数から数十秒の運転が可能なジャイロトロン管の典型 的な構造を,主要な構成部の名称とともに示す.図中には,



Fig. 2 最近の1 MW 級のジャイロトロンの構造を示す.

印加されている軸方向磁界の強度分布と軸上の電位の変化 を模式的に示した.以降の説明の助けとして各部の名称と 機能を箇条書きに記す.

- ・電子銃:マグネトロン入射型電子銃(Magnetron Injection Gun: MIG)と呼ばれる.円環状の電子放出帯より熱電子放射によって飛び出した電子は、軸方向磁界 と半径方向の電界により磁界と垂直方向に旋回しなが らキャビティ部に引き出され、中空状の電子ビームを 形成する.電界磁界の配位がマグネトロン発振器と同 様なためこう呼ばれる.
- ・キャビティ:円筒空胴共振器である.電子ビームの入り口側の直径を少し小さくし、出口側に広がるテーパーを持つ.これにより入り口側には電磁波が漏れず、出口側より電磁波の一部が取り出される.この共振器内において電子ビームの磁界と垂直方向のエネルギーの一部が電磁波に変換される.
- ・超伝導マグネット:電子銃部からキャビティ部に向かって強くなる軸方向磁界(ミラー磁界)を発生する(Fig.2の左側プロファイル).キャビティ部では電子のサイクロトロン周波数がキャビティの共振周波数に近くなるような磁界の強度に調整される.電子銃で放出された電子はこのミラー磁界中で磁界に垂直方向のエネルギーを増大する.
- ・モード変換器:キャビティで発生した電磁波は通常円形のTEm,nモードの複雑な電磁界分布を持つ.これを 直線偏波のガウス分布電磁波に変換するものである. 円筒状またはテーパー状の導波管壁面に周方向,軸方向に周期的な変形を与え,伝搬電磁波の強度分布を成型する.導波管を適当な境界で切断するとほぼガウス 分布の強度分布を持つ直線偏波電磁波が得られる.放射された電磁波はミラーによって適当に集光され出力 真空窓より取り出される.
- ・真空窓:真空管であるジャイロトロンと大気とを隔 て、かつ大電力ミリ波を取り出すための誘電体窓であ る。百ギガヘルツ帯においても誘電損失が小さく、真 空特性や冷却特性の優れた材料が要求される。近年 CVDダイアモンドの使用により、メガワット定常化が 画期的に進展した。

・コレクター:相互作用を終えた電子を最終的に捕集する電極である。キャビティに対して逆電圧をかけ、電子を減速して捕集するエネルギー回収型コレクター (Collector Potential Depression: CPD)が一般に使用される(Fig.2の右側プロファイル)。相互作用に寄与しない磁界と平行方向のエネルギーを回収して総合的な効率を向上させる。

5.3.2 ジャイロトロンの発振原理[3-5]

ジャイロトロンは制動放射型の発振器の一種であること はすでに第2章で述べた.電子のサイクロトロン角周波数 $\Omega_c = eB/\gamma m_0 が$,電子質量の相対論的な速度依存性により 変化することで,電子からの電磁波放射がコヒーレントに なるというサイクロトロン共鳴メーザー作用を利用してい る.ここで γ は相対論的係数である.この作用を説明する ために磁界中でサイクロトロン運動する電子と高周波電磁 界との相互作用の様子を Fig.3 に示した.

電子群は紙面手前方向の磁界中でラーモア半径 $r_{\rm L}$ で旋回 運動をしているとする.図の左上時刻t = 0の図にはラーモ ア円上に配置した電子群を示してある.電子はサイクロト ロン角周波数 Ω_c で反時計回りに旋回運動する.また高周 波電界ベクトル $E = E_0 \exp(j2\pi t/T_0)$ はこの時刻で下方向 を向いているとする.サイクロトロン角周波数 Ω_c と高周 波電磁界の角周波数 $\omega_0 = 2\pi/T_0$ は次の関係を満たすように 設定する.

 $\omega_0 \gtrsim \Omega_c \tag{1}$

このように周波数を選ぶと、図中に「減速電子」と示した 電子は常に減速電界を感じ、また「加速電子」と示した電子 は常に加速電界を感じることになる.しかしながら、電子 質量の相対論的変化を通じて減速電子は Ω_c が大きくなる ことにより旋回の位相が進み、一方加速電子は旋回の位相 が遅れるようになる.図中時刻 $t = 8T_0$ 付近で、電子がラー モア円の下方領域に集群しているのはこの事情を反映して



Fig. 3 電子群と高周波電磁界との相互作用による位相バンチン グの様子.

いる. 位相の進んだ減速電子は周波数差 $\Delta \omega = |\omega_0 - \Omega_c|$ が 小さくなるために同期して旋回するようになる. ところ が,位相の遅れる加速電子は位相差 $\Delta \omega$ がますます大きく なり,ついには減速位相領域にまで入ってくることになる (中の $t = 12T_0 - 16T_0$). こうしてある適当な周期の間だけ 電子と高周波電磁界との間に相互作用させれば,大半の電 子を減速位相に入れることができることになる. 減速位相 領域でラーモア半径が初期値に比べて小さくなっているこ とは,電子がエネルギーを失っている,すなわち電磁波と してエネルギーを放出していることを示している.

実際のジャイロトロンにおいては,電子は管軸方向に並 進運動をしているので,条件としてはドップラーシフトを 考慮して,

 $\omega_0 - k_{\parallel} v_{\parallel} \gtrsim \Omega_c \tag{2}$

となる. ここで k_{\parallel} と v_{\parallel} はそれぞれ磁界と平行方向の波動の 波数と電子の速度である. ただしキャビティにおいては k_{\parallel} は小さい.

5.3.3 ジャイロトロンの動作とパラメータ依存性

ジャイロトロンを実際に使用するものにとっては,封じ きられた真空管は全くのブラックボックスであり,外部か ら制御できるパラメータ(磁界強度や電圧)によって動作 がどのように変化するかは,なかなか理解しにくいもので ある.本節では,ジャイロトロンの構造から導かれる簡単 な関係を使って,その動作がどのように変化するかを直感 的に理解できるように説明を試みたい.

ジャイロトロンの構造の節で述べたように,ジャイロト ロンにおいて電子ビームの制御は重要な課題である.これ らの特性はいくつかのパラメータによって記述できる. Fig.4 はマグネトロン入射型電子銃の模式図を軸方向磁界 強度分布とともに示している.電子は電子放出帯と呼ばれ るベルト状の部分から熱電子放出される.カソードとア ノード間に印加された電圧 V_bにより電子は加速され,旋回 運動しながらキャビティー部に導かれる.こうして中空状 の電子ビームが形成される.

キャビティ部での電子ビームの諸量は、以下の考察により電子銃領域の諸量と関連づけられる.以下の議論においては、添え字kはカソード部での、添え字cはキャビティ部での諸量を表すものとする.

軸対称系における一般化角運動量の保存により、次式が



Fig.4 電子銃および関連パラメータ.

成り立つ.

$$\gamma m_{\rm e} r^2 \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t} - \mathrm{e} r A_{\phi} = -\dot{\Xi} \tag{3}$$

ここで, m_e は電子の静止質量, e は電荷, A_{ϕ} は円筒座標系 (r, ϕ, z)における ϕ 方向のベクトルポテンシャルである. 対 称軸に近い領域を考え, B = (0, 0, B(z))で, $A_{\phi} = rB(z)/2$ となることを使うと式(3)は,

$$\gamma m_{\rm e} r^2 \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t} - \mathrm{e} r^2 B/2 = -\dot{\Xi} \tag{4}$$

となる.電子放出帯部表面と、キャビティ部の $r = R_b$ の位置で $d\phi/dt = 0$ となることを利用して上式を適用することにより、

$$B_{\rm k}R_{\rm k}^{\,2} = B_{\rm c}R_{\rm b}^{\,2} \left(1 - \frac{r_{\rm L}^{\,2}}{R_{\rm b}^{\,2}}\right) \approx B_{\rm c}R_{\rm b}^{\,2} \tag{5}$$

が成り立つ.これは中空状電子ビームの断面を貫く磁束が 保存していることを意味している.これより

$$R_{\rm b} \approx R_{\rm k} \sqrt{\frac{B_{\rm k}}{B_{\rm c}}} = R_{\rm k} F_{\rm m}^{-\frac{1}{2}} \tag{6}$$

ここで、 $F_m = B_c/B_k$ はミラー比である.通常、電子放出帯 の半径 R_k は固定、またキャビティ部の磁界強度 B_c はサイ クロトロン共鳴条件でほぼ決定されるので、キャビティに おける電子ビーム半径 R_b はカソード部磁界 B_k の平方根に 比例して変化することがわかる.

キャビティ部における電子の旋回速度, さらには速度比 $a_c = v_{\perp c}/v_{\parallel c}$ が以下のように求められる.まず電子放出帯 からスタートする電子の初速度 $v_{\perp k}$ が $E \times B$ ドリフト速度 になることより,

$$v_{\perp k} = \frac{E_k \cos \theta_k}{B_k} = \frac{V_b \cos \theta_k}{dB_k} \tag{7}$$

である.諸量が断熱的に変化する系においては以下の量が 保存される.

$$\frac{p_{\perp}^2}{B} = -\hat{\mathcal{E}} \tag{8}$$

この量は非相対論的な極限では磁気モーメントに相当し、 磁気モーメントの保存に対応する、 $\gamma_k \approx 1$ であるので、この関係を使うとキャビティ部における磁界に垂直方向速度 $v_{\perp c}$ は、

$$v_{\perp c} = v_{\perp k} \frac{\gamma_k}{\gamma_c} \sqrt{\frac{B_c}{B_k}} \simeq v_{\perp k} \frac{F_m^{\frac{1}{2}}}{\gamma_c} = \frac{F_m^{\frac{1}{2}}}{\gamma_c} \left(\frac{V_b \cos \theta_k}{dB_k}\right) \quad (9)$$

で与えられ,さらに重要な量である速度比 ac は次式で与えられる.

ここで,

$$\alpha_{\rm c} = \frac{v_{\perp \rm c}}{v_{\parallel \rm c}} = \frac{\beta_{\perp \rm c}}{\beta_{\parallel \rm c}} = \frac{\beta_{\perp \rm c}}{(1 - \gamma_{\rm c}^{-2} - \beta_{\perp \rm c}^2)^{1/2}}$$
(10)

$$\gamma_{\rm c} = \frac{1}{(1 - \beta_{\perp}^2 - \beta_{\parallel}^2)^{1/2}} \simeq 1 + \frac{V_{\rm b}}{511} (\rm keV)$$
(11)

である. ただし $\beta = v/c$, cは光速である. 速度比 a_c は, ジャ イロトロンの発振に有効に使える磁界と垂直方向速度を表 しているので, a_c を高めることは発振出力の増大につなが る. 依存性は単純ではないが, 式(9)より一般に V_b を増 加, または B_k を減少させることにより出力を増やすことが できる.

次に発振周波数がどのように決まるかを考える. Fig.5 は、相互作用空間すなわちキャビティの形状、電子ビーム の位置、高周波電界の軸方向および径方向の分布を模式的 に示したものである.キャビティは半径 R_c を持ち直線部の 長さ L を持つ円筒形状である.中空状の電子ビームは、ミ ラー磁場により半径を R_b に圧縮され、また磁場に垂直方 向、平行方向速度比 a_c をおよそ 1.5 程度まで高められた状 態で、キャビティ中に入射される.このような円筒状キャ ビティは、TE モードに対して以下のようなとびとびの共 振周波数 $f_{cmn\ell}$ を持つ.

$$f_{\rm c,mn\ell} = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\left(\frac{\nu_{\rm mn}'}{R_{\rm c}}\right)^2 + \left(\frac{\pi\ell}{L}\right)^2} \tag{12}$$

ここで、 ν'_{mn} はベッセル関数の微分 $J'_{m}(x) = 0$ のn 番目の根 であり、 ℓ は軸方向モード数である.したがって、キャビ ティの幾何学的形状を決めると固有値 ν'_{mn} に対応した無数 の共振周波数が存在することになる.そこでキャビティ部 に印加する磁界強度を、サイクロトロン共鳴周波数がおよ



Fig.5 ジャイロトロンにおけるキャビティの形状,軸方向高周 波電界強度分布,キャビティ断面と径方向電界強度分布を 電子ビームとともに表示した.

509



Fig. 6 キャビティの共振周波数と磁界強度の関係.

そ共振周波数になるように設定することによって,発振 モードを選択できることになる.Fig.6は,84 GHz ジャイ ロトロンのキャビティを例として,その共振周波数スペク トルを棒線で示したものである.代表的なモードを TE_{m,n} の形で指示してある ($\ell = 1$ とした).灰色の帯で示したと ころに磁界強度を合わせると,例えば TE_{12,5}モードが選択 されたことになる.この時 R_c と L は共振周波数が 84 GHz になるように選んである.キャビティ部に印加する磁界強 度を変化させることにより次々とモードが選択され,異な る周波数の発振が起こる可能性がある.ただし発振が起こ るがどうかは後述する電子ビーム半径とも関連する.

ジャイロトロンの発振のしやすさは線形理論から導かれ る発振開始電流 I_{ST} によって判断できる[6].ここでは、 I_{ST} の表式は省略するが、84 GHz付近の発振について計算した 結果を Fig. 7に示す.キャビティの幾何学的形状としては、 周波数 84 GHz で TE_{12,5}モードに共振するような半径 R_c と長さ L を選んである.

図中に示した数字の組(m,n)は、発振モードが TE_{m,n} モードであることを示している。例えば、磁界強度を $B \simeq$ 3.33 T に固定し、電流をゼロから上昇してゆくと、およそ 20 A のところで発振が開始することになる。電子ビームと 電磁界との非線形な解析によれば[7]、一般に図中のハッ チで示したような低磁場側の縁のところに最大効率となる 動作点が存在するので、このような点で通常運転すること になる。ただし、運転中に電流値が減少するような可能性 がある場合には、出力は低下するが、より運転マージンの 広い高磁場側で運転しなければならない。

さらにこの図は、電流値が増加してくると、周波数の近 いモードである例えば TE_{9,6}モードと発振の競合を起こす 可能性があることを示唆している.このモード競合を避け る一つの方法として、キャビティ内での電子ビームの半径 を変える方法がある.Fig.8は、キャビティにおける電磁界 と電子ビームの結合の強さを規格化した半径についてプ ロットしたものである.TE_{12,5}モードと TE_{9,6}モードにつ いて計算した結果である.この値が大きい位置に電子ビー ムを合わせると発振がしやすくなる.TE_{12,5}モードに対し ては $r/R_c = 0.427$ に最大点が存在するが、この位置では TE_{9,6}モードの結合係数もかなり大きい.したがってモー ド競合を避けるには、ビーム位置をむしろ $r/R_c = 0.45$ くら いの少し外側に設定した方が有利であることがわかる.



Fig.7 線形理論で計算された発振開始電流 /sr.84 GHz 近傍の発振モードについてジャイロトロンの発振が起こる電流値をキャビティ部の磁界強度に対してプロットした.図中(m,n)は TE_{m,n}モードを示す.



Fig.8 電子ビームとキャビティ中での電磁界との結合係数.

ビーム位置を少し外に広げるにはもちろん式(6)よりカ ソード磁界強度 *B*_k を少し強くすればよい.

加速電圧 V_bについてはどうであろうか.ドップラーシフトした電子サイクロトロン共鳴条件を表す式(2)によれば, V_bを増加させて相対論的係数γが大きくなった場合でも共鳴条件を満たすには,キャビティ部の磁界強度を同様に増加させる必要があることも自明である.

最後に,発振効率について言及する.ジャイロトロンの 発振効率 η は次のように 3 つの部分に分解できる.

$$\eta = \eta_{\rm el} \eta_\perp \eta_{\rm dc} \tag{13}$$

ここで、 $\eta_{el} = a_c^2/(1+a_c^2)$ は電子ビームの持つ磁界に垂直 方向のエネルギーの割合であり、 η_{\perp} は純粋に電子の垂直方 向エネルギーから電磁波に変換される効率、そして $\eta_{dc} = V_b/V_c$ はエネルギー回収型コレクターを用いることに

よって回収されるエネルギーの割合である.通常この全効率 n は50%程度まで向上できる.

最後に、高効率運転での注意を述べておく.ジャイロト ロンが運転中に発振を停止した場合、例えば電流値が発振 開始電流以下になった場合等に起こりうるが、発振効率が 50%の場合には、本来50%程度の熱負荷しか考えていない コレクター部への電子のエネルギー入力が瞬時に100%に 上昇してしまうことになる.最悪の場合にはコレクター電 極を損傷してしまう可能性もある.ジャイロトロンを発振 させない状態、または不要なモードで発振させた状態で長 時間運転することのないように極力注意する必要がある.

5.4 高電圧電源の構成

ジャイロトロンの運転には複数の高電圧電源が使用され る. 文献[8]に詳細な記述があるので参考にしてほしい. 近 年,ジャイロトロンは,二極電子銃や三極電子銃のタイプ, エネルギー回収型コレクターを持つもの持たないものなど 多様化が進んでいる. それに合わせて電源の構成も変化し ている. また固体素子化も進められている. Fig.9は典型的 な高電圧電源の構成を示したものである.通常安全性の観 点より、大量の冷却水を使うコレクター(図中Cで示した) を接地電位で用いる.図(a)は二極電子銃を備えたジャイ ロトロン用であり、70 kV以上の高電圧で40A程度の大電 流を供給できる一種類の電源のみが必要であり最もシンプ ルである. ただし, CPD を使用しないためジャイロトロン の発振効率はせいぜいい30%程度となり、電源の使用効率 は悪い. (b)は、三極型電子銃と CPD を備えたジャイロト ロン用の典型的な電源構成である. 65 kV, 40 A 程度の大 容量電源の他に、小容量の35 kV、0.1 A 程度の電子引き出 し用電源(図中Aで示したアノードに印加)と85kV, 0.1 A 程度の電子加速用高電圧電源(図中Bで示したボディに







Fig.9 主な高電圧電源の構成.(a) 二極電子銃ジャイロトロン用 (b) 三極電子銃エネルギー回収型コレクタ (CPD) を備えた ジャイロトロン用電源(c) 二極電子銃 CPD ジャイロトロン 用,(d) 同ジャイロトロン用電源の異なる構成.

印加)とが必要になる、大容量の電源は精度の高い電圧安 定度は必要なく数%程度で十分であり、ローコスト化が可 能である.図(c)と(d)は二極電子銃を備えたCPDジャイロ トロン用の電源構成である.ジャイロトロンボディ部B はカソードKに対して85kV程度までの電位差が必要であ るが、(c)ではカソード基準でプラス電圧を印加し、また (d)ではコレクター基準でプラス電圧を印加している. (d)の場合,低電圧,小容量の電源ですむので経済的であ るが、65 kVの大容量電源の電圧安定度を向上する、また はフィードバックにより K-B間の電位差を一定に保つよう な工夫が要求されることになる.ただし,いずれの場合に おいても、ジャイロトロンや高周波系を保護するために、 高速の電流遮断機能が不可欠である.最近は経済性と信頼 性の観点から、65 kV 程度の大容量電源を固体素子で構成 し、電圧安定化をはかり、複数台のジャイロトロンに電力 を供給し、20 kV 程度の小容量ボディ電源を各々のジャイ ロトロンに個別に設置する方式で,二極電子銃型CPDジャ イロトロンを複数台一度に駆動するという方向に向かいつ つある.

5.5 大電力ミリ波伝送系とアンテナの構成

ミリ波伝送系は、ジャイロトロンで発振した大電力ミリ 波をプラズマ装置まで低損失で長距離伝送する重要なシス テムである.世界的には、第2章で説明したコルゲート導 波管を用いる伝送方式と, ミラー列によるビーム伝送方式 が用いられている.コルゲート導波管伝送は、ミリ波を空 間的に狭い領域に閉じ込めておくことができる反面、パ ワー密度が比較的高いので真空化や十分な冷却が必要とな ることがある. 大規模なシステムとしては, LHD をはじめ DIII-D (米国), ASDEX (ドイツ), TCV (スイス), Tore Supra (フランス) 等のプラズマ装置で採用されている. ビーム伝送方式は、大きなミラーを使用することにパワー 密度を下げ大気中でも伝送が可能である. また伝送損失が 比較的小さいと言われている。欠点としては電磁波遮蔽と して大きなダクトが必要になり,規模が大きくなる傾向が ある. TJ-II (スペイン) や建設中の W7-X (ドイツ) で採用 されている[9],

ここでは、LHDで採用されているコルゲート導波管伝送 について、主要なコンポーネントを含めて概要を説明す る.尚、詳細な解説は[10]に記述されている.Fig.10に LHDにおける 84 GHz ジャイロトロンの写真を示した. ジャイロトロン本体は超伝導マグネットに挿入され、電子 銃部は油絶縁タンク内に浸っている.多数の冷却水配管に よりジャイロトロン各部を強制水冷している.出力窓から のミリ波は MOU 内に納められているミラー列によりコル ゲート導波管に導かれている.

(1) MOU

ジャイロトロンからのミリ波出力は、出力窓の温度上昇 を緩和するために、通常真空窓上でのパワー分布を平坦化 して取り出している.したがって、ジャイロトロン出力を 効率良くコルゲート導波管に結合するには、位相補正鏡を 用いて出力電磁波の強度および位相を修正して、最適の強



Fig. 10 ジャイロトロンシステム, ジャイロトロン本体と超伝導 マグネット, 油絶縁タンク, MOU, コルゲート導波管を 示す.

度,位相分布で導波管入り口に結合しなければならない. 位相補正鏡の設計には、ジャイロトロンからの出力分布を 複数箇所で測定し、その強度分布より位相情報を再構成す るという方法で位相情報を知り、それによって位相補正鏡 を設計している[11-14].計算によれば原理的には結合効 率95%を超えるような値が得られている.

(2) コルゲート導波管

LHD で使用されているコルゲート導波管を Fig.11 に示 す.8系統の伝送路があり、そのうち6系統が図に示した 直径 88.9 mm の導波管であり(1系統が真空排気されてい る)、残り2系統が直径 31.75 mm の真空排気された導波管 である.双方ともアルミニウム製であり、1 m または2 m のものを複数接続して使用している.特に直径 88.9 mm のコルゲート導波管は、コルゲーションのピッチが0.8 mm、リブの幅が0.2 mm、高さが0.6 mm になっており、80 -180 GHz に渡る広帯域において損失が少ない.コルゲート 導波管についてはその特性について理論的、実験的検討が なされており[15,16]、ミリ波のオーミック損失は2 dB/ km以下であることが実験的に検証されている.一般に、導 波管径が大きくなるほど損失は減少し、また損失の小さい 周波数帯域が広がる傾向にある、

第2章にあるようにコルゲート導波管の主伝搬モードは HE₁₁モードであり、このモードは真空中のガウスビームに 近い強度分布と偏波を持っている.この2つのモードの結 合効率を最大にするには、導波管入り口においてガウス ビームのビームウエストを設定し、そのウエスト半径 w_0 と導波管の半径Rとの間に $w_0/R = 0.643$ の関係が成り立つ 必要がある[17].ここで、 w_0 はガウスビームの電界につい てのウエスト半径である.

ガウスビームを有効にコルゲート導波管に結合するため には、次の3つの条件を満足しなければならない.1)ガウ スビームの伝搬軸は、導波管軸に一致させなければならな い、2)ビームの中心は、導波管開口の中心に一致させなけ ればならない.3)ガウスビームのウエストサイズは、上記 のように導波管に適合した半径を持って入射させなければ ならない.これらの条件からのずれは、導波管の傾き、オ



Fig. 11 内径 88.9 mm のコルゲート導波管列.

フセット,径変化につながり,結合効率の低下を招く.こ の結合効率については詳細な検討がなされており,次式の ようなスケーリングが得られている.最適ビームウエスト を持つガウスビームを導波管中のHE₁₁モードと結合する 場合に,導波管とビームの軸ずれと傾きによって発生する 変換損失は,

$$L_{\text{offset}} = 2.3 \left(\frac{r_{\text{d}}}{a}\right)^2 - 2.2 \left(\frac{r_{\text{d}}}{a}\right)^4 \text{ for } r_{\text{d}}/a < 0.45$$
 (14)

$$L_{\text{tilt}} = 3.9 \left(\frac{a\theta}{\lambda}\right)^2 - 5.6 \left(\frac{a\theta}{\lambda}\right)^4 \quad \text{for} \quad \left|\frac{a\theta}{\lambda}\right| < 0.43 \qquad (15)$$

で与えられる.ここで*a* は導波管半径, r_d は軸ずれ, θ (ラ ジアン)は傾き, λ は波長を表す[17].例えば,周波数 168 GHz で直径 88.9 mm のコルゲート導波管にガウスビーム を入射する際に,モード変換損失を 1% 以下に抑えるため には,軸ずれは 2.9 mm 以下,傾きは 0.1 度以下に抑えなけ ればならないことになる.ガウスビームの導波管への導入 や,導波管系の精密なアラインメントに関しては,ビーム パタンのモーメントや位相情報に基づいて行う新しい方法 が提案されている[18].

(3) マイターベンド

マイターベンドは、コルゲート導波管系において電磁波 を典型的には90度曲げるコンポーネントである. Fig. 12 に示したように、一般に90度でつきあわされた円形コル ゲート導波管と平面の反射板から構成される.マイターベ ンドにおける損失には次の3種類がある.まず反射板にお けるオーミック損失.理想的な状態でも起こるモード変換 損失.それとミスアラインメントによるモード変換損失で ある.反射板へ入射角 ϕ で入射した平面波のオーミック損 失は、次のように偏波に依存する.

オーミック損失=4
$$\frac{R_s}{Z_0}\cos\phi$$



Fig. 12 マイターベンドの構造.

:電界の方向が反射面に垂直の場合(16)

オーミック損失 = $4\frac{R_s}{Z_0}/\cos\phi$:電界の方向が反射面に平行の場合(17)

ここで, R_s は反射板の表面抵抗, Z_0 は真空のインピーダンス377 Ω である.

理想的な状態でのモード変換損失とは、反射面に対して 導波管を折り返してみればわかるように、波動がマイター ベンドに入射するとき、ちょうど導波管直径だけギャップ を隔てて伝搬するように見えることから起こるものであ る.この損失は、導波管直径をD、ギャップ長さをLとし たときのギャップ損失と考えられ、

ギャップでの損失 =
$$1.1(\lambda L/D^2)^{3/2}$$
 (18)

から, *L*=*D* とおいて得られる. 導波管のコルゲーション を反射板まで加工した場合には,損失は上記のおよそ半分 になると考えられる.これは理想的な90度ベンドの場合で あり,反射板のミスアラインメントによって90度からずれ ることがあるとさらに損失は増加することになる.これは 式(15)で与えられる損失が付加されることになる.

Fig. 13(a)は、マイターベンド部において導波管ギャップ ができることによる損失を、反射板でのオーミック損失と あわせてパーセントで表示した. 周波数が低いほど, また 導波管径が小さいほどビームの広がりが大きくなり損失は 増大する. 管径の小さな導波管では、マイターベンド前後 にモード変換器をつけるなどしてこのギャップ損失を低減 する必要がある.オーミック損失は、反射板材料を銅とし、 その抵抗率を常温時の2倍の値を採用しているが、それほ ど大きくはない.図(b)は、マイターベンドでの導波管角 度が90度からずれた場合のモード変換損失を示している. 図では角度のずれを0.1度としている.この場合,周波数が 高いほど、また導波管径が大きいほど損失が増加する。こ れは伝搬できるモード数が増加することに起因している. これらの損失をすべて考慮すると百ギガヘルツ帯の伝搬で は、1マイターベンドあたり最低でも1%程度の損失を覚 悟しなければならず、全系での伝送効率の向上にはマイ



Fig. 13 マイターベンドにおけるミリ波の損失.(a) ベンド部で 導波管にギャップができることによる損失,および反射 板でのオーミック損失をパーセントで表示.(b) ベンド 部で角度が90度からずれることによる損失.ずれを0.1 度とした場合.

ターベンド数を減らす努力をしなければならない. (4) 偏波器

ECHによる有効なプラズマ加熱のためには,入射電磁波 の偏波を加熱モードや入射角に合わせて適切に設定する必 要がある.一般には入射電磁波の楕円偏波度とその主軸を 制御する必要がある.構成としてはおよそ 1/4 波長の溝を 加工したコルゲート反射板と, 1/8 波長の溝を加工したコ ルゲート反射板の組み合わせで任意の主軸を持った楕円偏 波を形成させる.偏波器の原理的な記述は[19-21]に詳し いので割愛する.マイターベンドの反射板を上記のコル ゲート反射板で置き換えて構成した偏波器の実際をFig.14 に示す.コルゲート反射板はモーター駆動で回転できるよ うになっている.さらにコルゲート反射板は長パルス運転 時の冷却のために水冷できる構造になっている.

(5) ダミーロード

ダミーロードは、ジャイロトロンからの出力の測定や、 伝送系での伝送効率の評価、プラズマ装置への入射パワー の評価など、大電力長パルスのミリ波パワーを測定するた めに必要な装置である.通常、間接的または直接的に水に 電磁波を吸収させ、その温度上昇からパワーを求めるもの



Fig. 14 (a)マイターベンド部に組み込まれた偏波器.(b)反射板 は銅製のコルゲート反射板になっている.この反射板を 回転することによって偏波を変更できる.反射板は水冷 できるようになっている.

である. Fig. 15 はその構造を模式的に示したものである. (a)は間接吸収型であり、アルミニウムの表面に二酸化チ タンなどをプラズマ溶射しキャビティを構成させたもので あり、多重反射によってミリ波パワーを吸収する. その熱 はアルミニウム容器の外側を流れる冷却水に吸収され、そ の入口, 出口の温度差と冷却水量によりパワーを算出す る. (b)は、ミリ波を低損失セラミックなどを介して直接 冷却水に吸収させるものである. 短パルス用としてはテフ ロンのチューブを巻いたものを用いるが、長パルスから定 常用としては低損失窒化珪素材などを用いる.(c)はパ ワーの測定はできないが、長パルスの大電力のミリ波の無 反射終端としてコンディショニング用として用いるもので ある. ミリ波の吸収体としては耐火レンガなどを用いる. Fig. 16 は実際のダミーロードを示している. パルスダミー ロードは間接吸収型, 定常用ダミーロードは直接吸収型で ある.

(6) パワーモニター

実際にプラズマ装置にパワーを入射しているときに、入 射パワーをモニタしておく必要がある.ジャイロトロンの 出力などは, MOU に取り付けられた小孔などを通して漏 れ出てくる電磁波をクリスタル検波器で受信してモニタす る、しかしながらこの信号は MOU 内の進行波や反射波の 影響を受けその振幅は必ずしもパワーに比例したものでは なく、ジャイロトロンが一定のパワーを発振していたとし ても、伝送系での反射の仕方、ジャイロトロンの微小な周 波数の変化などによって時間的に激しく変動してしまう. 伝送出力に比例するパワーモニタとして考案され、製作さ れたものを Fig. 17 に示す. これはマイターベンドの反射板 に組み込まれたものであり、反射板の中心付近に小孔列を 孔径を変化させながらあける.その反対側には副導波管と なる標準矩形導波管を作りつけ、反射板で反射する電磁波 の一部を結合させ、その信号をクリスタル検波器で受信す るものである[22]. 主コルゲート導波管内の電磁波の進行 方向に対して指向性があり進行波と反射波の区別が可能で ある.また、小孔列を2列に作り2つの副導波管の各々H 面と E 面が接するようにすると、2 つの方向の電界強度を モニタでき、それらの信号より伝搬電磁波の偏波がリアル タイム判別できるような装置も開発されている[23]. (7) その他のコンポーネント



Fig. 15 ダミーロードの概念図. (a)間接吸収型, (b)直接吸収 型, (c)コンディショニング用ダミーロード.



Fig. 16 パワー評価用ダミーロード.パルスと定常 (CW) で使用 が可能なもの.

その他のコンポーネントとして挙げられるものは、伝送 系内でのアーキングを光学的に検知しジャイロトロン発振 を停止させるアークディデクタ、導波管の経路を変更する 導波管切替器、プラズマ装置などと電気的に絶縁する DC ブレイク、真空排気用導波管セクション、プラズマ装置へ の入射真空窓などがある。残念ながら紙面の都合上これら を詳細に記述できないが、これらのコンポーネントは高パ ワーミリ波用という特殊な用途のため、現在も日々開発、 改良が進められているものであることを付け加えておく. (8) アンテナ

コルゲート導波管によってプラズマ装置に導かれたミリ 波は,導波管端よりガウスビームの形で放射される.第2 章で述べたように,ガウスビームは放射後ガウスビーム光 学に従って伝搬することになる.ミリ波は構成される部品 サイズに比べて十分波長が短いため,準光学的に取り扱う ことができ,プラズマ加熱用のアンテナは,通常複数枚の ミラー系によって構成できる.入射配置によって固定鏡や 可動鏡,集光鏡や平面鏡から構成されることになる.しか



Fig. 17 (a)マイターベンド部に組み込まれたパワーモニタ.(b) 構造図.パワーモニタはマイターベンドミラー中心部に 複数の穴を開け、反対側に密着させられた副導波管にミ リ波の一部を結合させて、ミラーを反射するパワーを評 価するものである.

しながら、可視光に比べて十分波長は長いので、通常の鏡 ではなく、金属の機械加工面で十分鏡として機能する.面 粗度としてはλ/100を要求するとしても10µm程度である. ただし、規則的な加工痕はグレーティングとして働くこと もあるので光学研磨を施した方が良い.Fig.18は、LHD 装置において使用されている上部ポートアンテナの模式図 を示している.一つのポートより2ビームの入射が可能で ある.アンテナは4枚のミラーから構成され、2枚の集光 鏡と2枚の平面鏡からなる.ミリ波ビームはLHDプラズ マの縦長断面に入射されるため、赤道面でトロイダル方向 に長く、半径方向に短い楕円形状(ビームウエスト半径で 50 mm×15 mm)に集光されるようになっている.プラズ マに一番近いミラーは可動鏡でありトロイダル方向、半径 方向に焦点位置を移動できる.

近年,ITER用のECH,ECCDアンテナとして遠隔ミ ラー駆動型アンテナ(Remote Steering Antenna:RSA)の 研究が進められている.有効なプラズマ加熱や,電流駆動 を行うためには,可動鏡をできるだけプラズマに近く設定 する必要がある.ITERではブランケットの背面部に可動 水冷部を備える最終ミラーを設置しなければならなくな る.そこで,長い導波管の入口である角度をつけてミリ波 ビームを入射したら,出口において適当な角度で放射でき ないかという発想に基づいて考案されたのがRSAである. Fig.19にその概念図を示す.一辺の長さが*a*,全長*L*の矩 形コルゲート導波管の入口に可動鏡を設置し,これによっ てミリ波ビームの入射角を炉の外から制御する.



Fig. 18 LHD 装置の ECH 用上部ポートアンテナの模式図.



Fig. 19 遠隔ミラー駆動型アンテナ(リモートステアリングアン テナ)の概念図.

 $L = 8a^2/\lambda$ の関係が満たされるとき,入射角に等しい角度 で導波管出口からミリ波ビームが放射される[24,25].こ れによって可動水冷部をプラズマ近くに設置する必要がな くなる.導波管の長さが上記の半分である $L = 4a^2/\lambda$ の場 合には,反対称な放射となって,角度の絶対値が等しく, 方向が入射方向とは反対になる.

5.6 技術的課題と将来展望

ITER 等の大規模 ECH システムの構築は,パワーソース であるジャイロトロン管の地道な研究開発により,当初の 目標であった単管 1 MW 定常運転がほぼ実現され,大きく 前進した.ECH は核融合プラズマの加熱手段として,また プラズマ制御のための手段として確固たる地位を築いてい る.システム構築の技術課題は,大電力を取り扱うための 工学的な課題に移行しつつある.

ジャイロトロン管の効率は,高効率化が図られたといっ ても50%程度であり,残りの半分のパワーは大規模な冷却 設備などで処理する必要がある.またミリ波伝送の効率も どんなに最適化が進められても15%程度の伝送損失は発生 してしまう.メガワット級の設備においては数百 kW 定常 の発熱を処理してゆくのは大変なことになる.したがって 今後の課題としては,すべてのコンポーネントに対して一 層の高効率化を進めることが重要である. ECH 装置の場合どうしても複数台のジャイロトロンを 同時運転していかなければならないので,安定性,信頼性 の高いシステムの構築が大事である.それにはシステムを できるだけシンプルに構成するのがよい.

ジャイロトロンの単管出力を向上し,同時運転するべき 台数を減らしていくのも肝心である.必要とされる高電圧 電源を共通化したり,簡略化してトラブルの少ないものに し,固体素子化を進めて信頼性を高め,メンテナンスしや すくし,装置としての寿命を延ばしていく必要がある.伝 送系としては,スペースファクタと安全性からコルゲート 導波管伝送が基本であろう.もちろん準光学的なコンポー ネントは併用することになる.経路なども複雑にならず, 屈曲が少なく,できるだけ簡略化して一層の伝送効率向上 をめざしていくことが肝要である.

参考文献

- [1] T. Imai, J. Plasma Fusion Res. 81, 178 (2005) (in Japanese).
- [2] Y. Ikeda and S. Kubo. J. Plasma Fusion Res. 81, 160 (2005) (in Japanese).
- [3] Edited by C.J. Edgcombe, *Gyrotron Oscillators* (Taylor & Francis Ltd, 1993).
- [4] T. Okamoto and K. Sugimori, Kakuyugo Kenkyu 51, 369 (1984) (in Japanese).
- [5] K. Sakamoto and T. Imai, J. Plasma Fusion Res. **71**, 5 (1995) (in Japanese).
- [6] K.E. Kreischer and R.J. Temkin, Int. J. Infrared and Millim. Waves **2**, 175 (1981).
- [7] B.G. Danly and R.J. Temkin, Phys. Fluids 29, 561 (1985).
- [8] K. Ohkubo, J. Plasma Fusion Res. **73**, 613 (1997) (in Japanese).

- [9] V. Erckmann, P. Bland et al., Proc. on 16th Topical Conference on Radio Frequency Power in Plasmas (AIP 2005) p.371.
- [10] S. Kubo, Kakuyugo Kenkyu 66, 581 (1991) (in Japanese).
- [11] A.V. Chirkov, G.G. Denisov and N.L. Aleksandrov, Optics Communications 115, 449 (1995).
- [12] Y. Hirata, K. Komuro, Y. Mitsunaka *et al.*, IEEE Trans. on Microwave Theo. Tech. 47, 1522 (1999).
- [13] D.R. Denison, T.S. Chu, M.A. Shapiro and R.J. Temkin, IEEE Trans. on Plasma Science **27**, 512 (1999).
- [14] M.A. Shapiro, T.S. Chu, D.R. Denison *et al.*, Fusion Eng. Des. 53, 537 (2001).
- [15] J. Doane, *Infrared and Millimeter Waves*, 13, Chap. 5 (Academic Press, New York 1985).
- [16] K. Ohkubo, S. Kubo *et al.*, Int. J. Infrared and Millim. Waves 15, 1507 (1994).
- [17] K. Ohkubo, S. Kubo *et al.*, Int. J. Infrared and Millim. Waves 18, 23 (1997).
- [18] T. Shimozuma, H. Idei *et al.*, J. Plasma Fusion Res. **81**, 191 (2005).
- [19] M. Saigusa J. Plasma Fusion Res. 79, 844 (2003) (in Japanese).
- [20] J. Doane, Int. J. Infrared and Millim. Waves 13, 1727 (1992).
- [21] K. Nagasaki, A. Isayama and A. Ejiri, Rev. Sci. Instrum. 66, 3432 (1995).
- [22] W. Kasparek, Int. J. Infrared and Millim. Waves, 24, 451 (2003).
- [23] T. Notake, H. Idei, S. Kubo *et al.*, Rev. Sci. Instrum. 76, 023504 (2005).
- [24] A. V. Chirkov, G. G. Denisov *et al.*, Fusion Eng. Des. 53, 465 (2001).
- [25] K. Ohkubo, S. Kubo et al., Fusion Eng. Des. 65, 657(2003).

百ギガヘルツ帯のミリ波の応用:ミリ波レーダーを利用した車両の安全システム

現在,世界中で120万人が毎年交通事故で亡くなって おり,交通事故死傷者低減は,大きな課題である.日本 国内の交通事故解析結果によると,死亡・重傷事故の約 70%は前方不注意,安全不確認など,ドライバーの認識 遅れが原因となっている.また,同じく交通事故解析結 果より,事故時,ブレーキやハンドル操作等のドライ バーの事故回避操作がないまま衝突に至る場合が約40% もあることがわかる.したがって,レーダ等の周辺監視 技術を用いてドライバーの認知,判断,操作を支援する システムは,交通事故件数および死傷者の大幅な低減に 大きな効果をもたらす可能性を持っており,世界中で精 力的に研究開発が行なわれている.

周辺監視技術を応用した代表的な安全システムは、プ リクラッシュセーフティ (PCS) であり、このシステム は、プリクラッシュセンサ (Pre-Crash Sensor) と衝突警 報そして衝突被害軽減システムであるプリクラッシュ シートベルト (Pre-Crash Seat Belt), プリクラッシュブ レーキ (Pre-Crash Brake), プリクラッシュブレーキア シスト (Pre-Crash Brake Assist) およびサスペンション コントロール (Suspension Control) 等で構成されている. プリクラッシュセンサは、ミリ波レーダとヨーレートセ ンサ等の各種センサおよび衝突判断コンピュータ、さら にカメラ等も組み合せ構成されている.障害物との距 離,相対速度および方向,物体の大きさ等を検知し,衝 突までの予測時間と自車の進路や相手車両の予想進路等 から衝突を予測する、プリクラッシュセンサにより衝突 の可能性があると判断された場合、警報音と共にメータ 内に"ブレーキ"と表示し、ドライバーにブレーキ操作 を促す. そしてドライバーがブレーキ操作を行なった場 合、プリクラッシュブレーキアシストを作動させ、通常 のブレーキの約2倍の制動力を発生させる.同時に ショックアブソーバーの減衰力を適正化し、ブレーキ時



藤田浩一(トヨタ自動車株式会社 第2電子技術部)

車両搭載状態のミリ波レーダ



項目	仕様
方式	電子式ビームスキャン
発振周波数	76GHz帯
検知距離	150m程度
検知範囲	左右各約10°
検知速度範囲	-200~+100km/h
外形寸法	幅107×高さ77×奥行53mr

のフロントノーズダイブ量等を抑制する.万一ドライ バーがブレーキ操作を行なわなかった場合でも、衝突不 可避なタイミングでブレーキを作動させ(プリクラッ シュブレーキ),衝突速度を低減する.さらに、乗員に対 しては、プリクラッシュシートベルトを作動させ、衝突 前にモーターでシートベルトを巻き取り、衝突があった 場合の乗員初期拘束力を高め、前方移動量を低減し、乗 員の傷害を軽減する[1,2].

プリクラッシュセーフティシステムに使われている レーダは、前方障害物検知センサとして、悪天候や汚れ 等の環境要因の影響を受け難く対向車等も検知可能なミ リ波が採用されている.ミリ波レーダの構成は、フェー ズドアレイ方式による電子スキャン型で、ミリ波回路や 信号処理回路を IC 化することにより小型でかつ高性能 化が図られ、車両への搭載を容易にしている.また、車 間距離を制御し設定速度の範囲内で前車に追従走行する アダプティブクルーズコントロール(ACC)用と兼用す ることで、低コスト化、センサ規模の簡素化が図られて いる.フェーズドアレイ方式とは、受信(あるいは送信) アンテナの隣接アンテナ間の電気的位相差を制御するこ とで、ビームスキャンしたり、位相差を解析することで 検出物体の方向を特定する手法である[3].

プリクラッシュセーフティは、まだ第一歩ではある が、事故のない社会実現に向け、前面の衝突にとどまら ず、今後側突、後突などの様々な形態の事故にも応用可 能な交通事故低減技術として更に発展することが期待さ れている.

参考文献

- [1] 自動車技術 59, No.12 (2005).
- [2] "Pre-Crash Safety System",11th World Congress on ITS (Nagoya, Aichi, Japan 2004) No.3352.
- [3] "Electronically Scanned Millimeter-wave Radar for Pre-Crash Safety and Adaptive Cruise Control System" IEEE IV2003, June 9-11, 304-309(2003).